

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
25. Juli 2002 (25.07.2002)

PCT

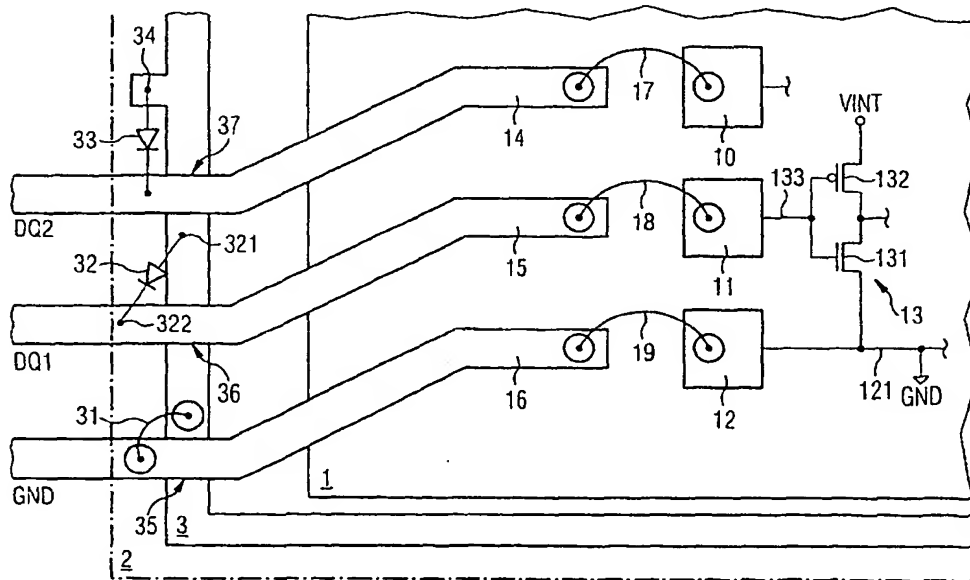
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 02/058154 A2**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 27/02 (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TROOST, Marco  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/00175 [DE/DE]; Kandinskystrasse 27, 81477 München (DE).  
(22) Internationales Anmeldedatum: 21. Januar 2002 (21.01.2002) (74) Anwalt: EPPING, HERMANN & FISCHER; Ridler-  
strasse 55, 80339 München (DE).  
(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
(30) Angaben zur Priorität: 101 02 354.5 19. Januar 2001 (19.01.2001) DE NL, PT, SE, TR).  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-  
Martin-Str. 53, 81669 München (DE). Veröffentlicht:  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu  
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING ESD PROTECTION

(54) Bezeichnung: HALBLEITER-BAUELEMENT MIT ESD-SCHUTZ



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising ESD protection elements (32, 33) arranged outside the semiconductor body (1) and connecting an additional strip conductor (3) guiding a reference potential (GDN), to strip conductors of the leadframes (14, 15). ESD protection structures integrated into the semiconductor body (1) are thus no longer required, and the correspondingly high surface consumption is eliminated.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/058154 A2



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

Docket # P2001,0034

Applic. # \_\_\_\_\_

Applicant: Marco Troost

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

**(57) Zusammenfassung:** Ein Halbleiterbauelement weist ESD-Schutzelemente (32, 33) auf, die außerhalb des Halbleiterkörpers (1) angeordnet sind und eine Bezugspotential (GDN) führende zusätzliche Leiterbahn (3) mit Leiterbahnen des Leadframes (14, 15) verbinden. Auf dem Halbleiterkörper (1) integrierte ESD-Schutzstrukturen sind nicht mehr erforderlich, der entsprechend hohe Flächenverbrauch wird gespart.